

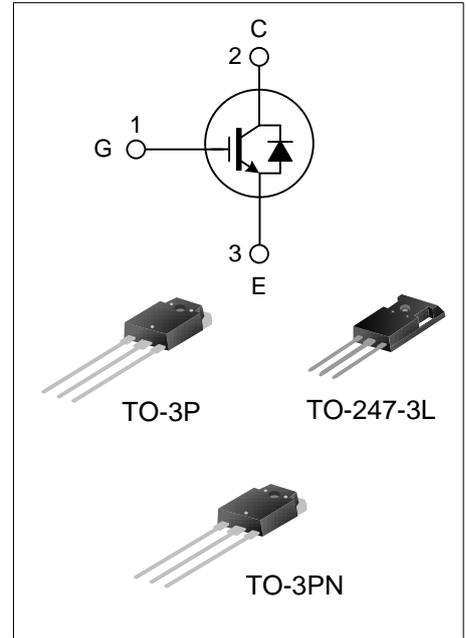
60A、650V绝缘栅双极型晶体管

描述

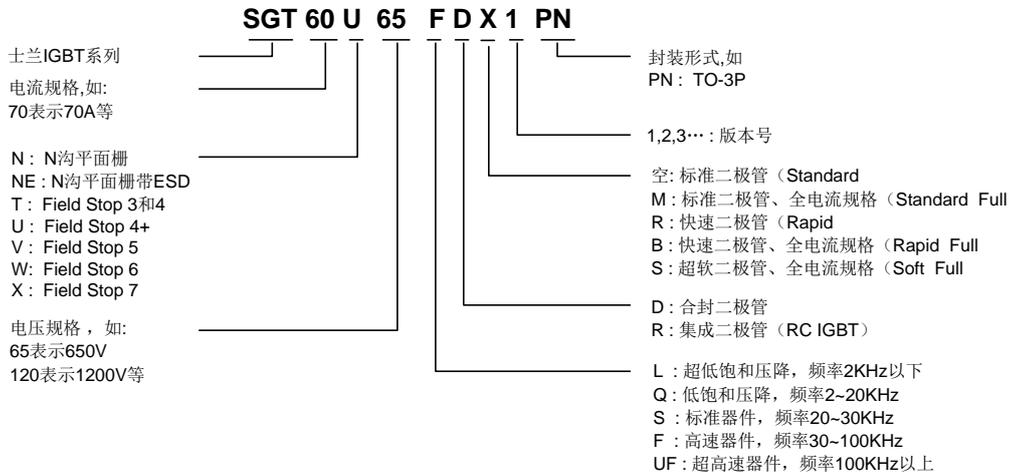
SGT60U65FD1PN(PT)(P7)绝缘栅双极型晶体管采用士兰微电子场截止 4 Plus (Field Stop IV+) 工艺制作, 具有较低的导通损耗和开关损耗, 该产品可应用于 UPS, SMPS 以及 PFC 等领域。

特点

- 60A, 650V, $V_{CE(sat)}(\text{典型值})=2.0V@I_C=60A$
- 低导通损耗
- 快开关速度
- 高输入阻抗



命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SGT60U65FD1PN	TO-3P	60U65FD1	无铅	料管
SGT60U65FD1PT	TO-3PN	60U65FD1	无铅	料管
SGT60U65FD1P7	TO-247-3L	60U65FD1	无铅	料管

极限参数（除非特殊说明， $T_c=25^{\circ}\text{C}$ ）

参数	符号	参数范围	单位
集电极-发射极电压	V_{CE}	650	V
栅极-发射极电压	V_{GE}	± 20	V
集电极电流	I_C	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	120
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$	60
集电极脉冲电流	I_{CM}	180	A
二极管电流	I_F	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	60
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$	30
耗散功率（ $T_C=25^{\circ}\text{C}$ ）	P_D	280	W
工作结温范围	T_J	$-55\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参数	符号	参数范围	单位
芯片对管壳热阻（IGBT）	$R_{\theta JC}$	0.45	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
芯片对管壳热阻（FRD）	$R_{\theta JC}$	1.17	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

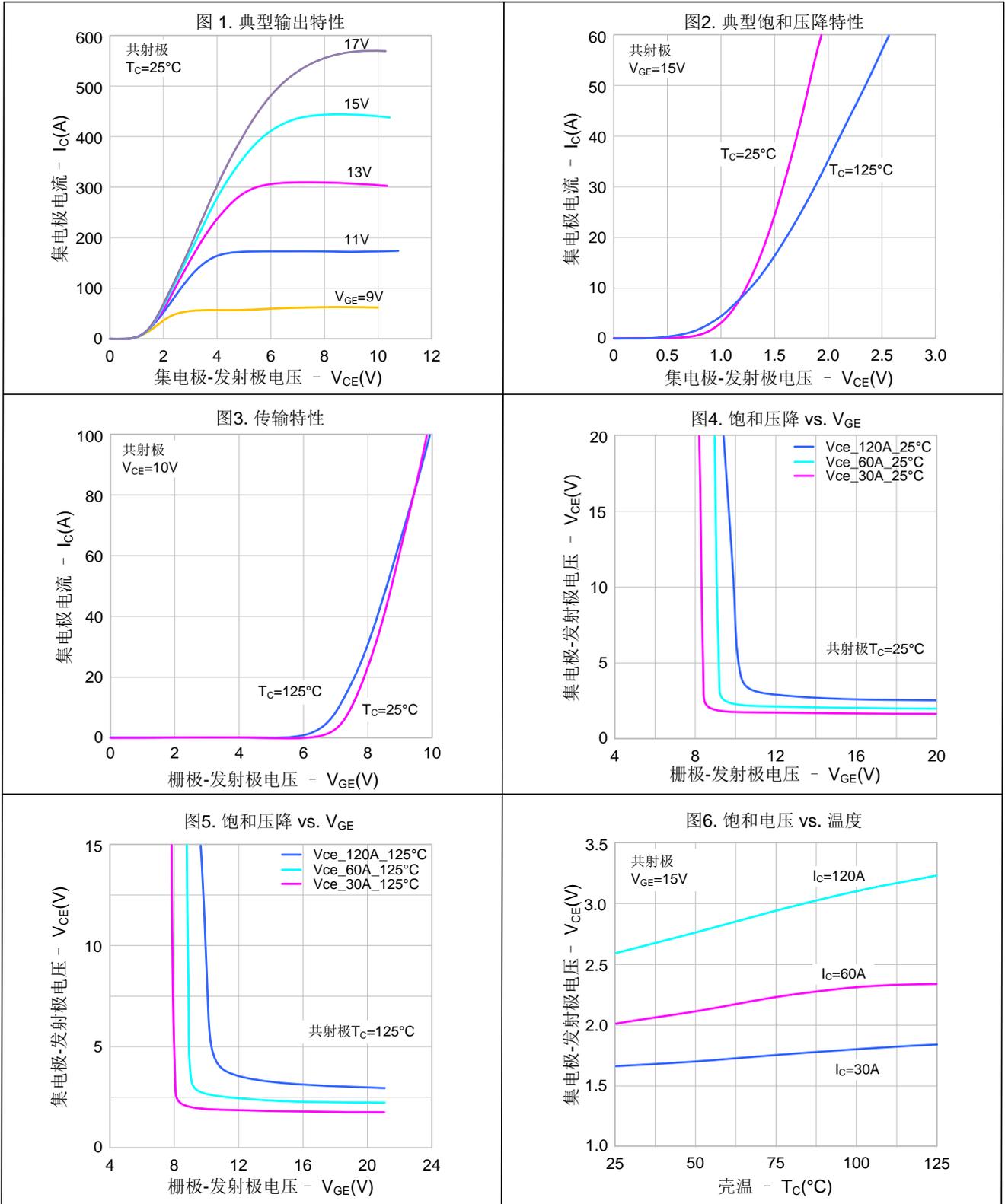
IGBT 电性参数（除非特殊说明， $T_c=25^{\circ}\text{C}$ ）

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集射击穿电压	BV_{CE}	$V_{GE}=0\text{V}, I_C=250\mu\text{A}$	650	--	--	V
集射漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=650\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$	--	--	200	μA
栅射漏电流	I_{GES}	$V_{GE}=20\text{V}, V_{CE}=0\text{V}$	--	--	± 400	nA
栅极开启电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=250\mu\text{A}, V_{CE}=V_{GE}$	4.0	5.0	6.5	V
饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=60\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	2.0	--	V
		$I_C=60\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_C=125^{\circ}\text{C}$	--	2.5	--	V
输入电容	C_{ies}	$V_{CE}=30\text{V}$	--	6730	--	pF
输出电容	C_{oes}	$V_{GE}=0\text{V}$	--	132	--	
反向传输电容	C_{res}	$f=1\text{MHz}$	--	62	--	
开启延迟时间	$T_{d(on)}$	$V_{CE}=400\text{V}$ $I_C=60\text{A}$ $R_g=10\Omega$	--	70	--	ns
开启上升时间	T_r		--	160	--	
关断延迟时间	$T_{d(off)}$		--	190	--	
关断下降时间	T_f		--	140	--	
导通损耗	E_{on}	$V_{GE}=15\text{V}$	--	3.8	--	mJ
关断损耗	E_{off}	感性负载	--	1.5	--	
开关损耗	E_{st}		--	5.3	--	
栅电荷	Q_g	$V_{CE}=400\text{V}, I_C=60\text{A}, V_{GE}=15\text{V}$	--	210	--	nC
发射极栅电荷	Q_{ge}		--	65	--	
集电极栅电荷	Q_{gc}		--	70	--	

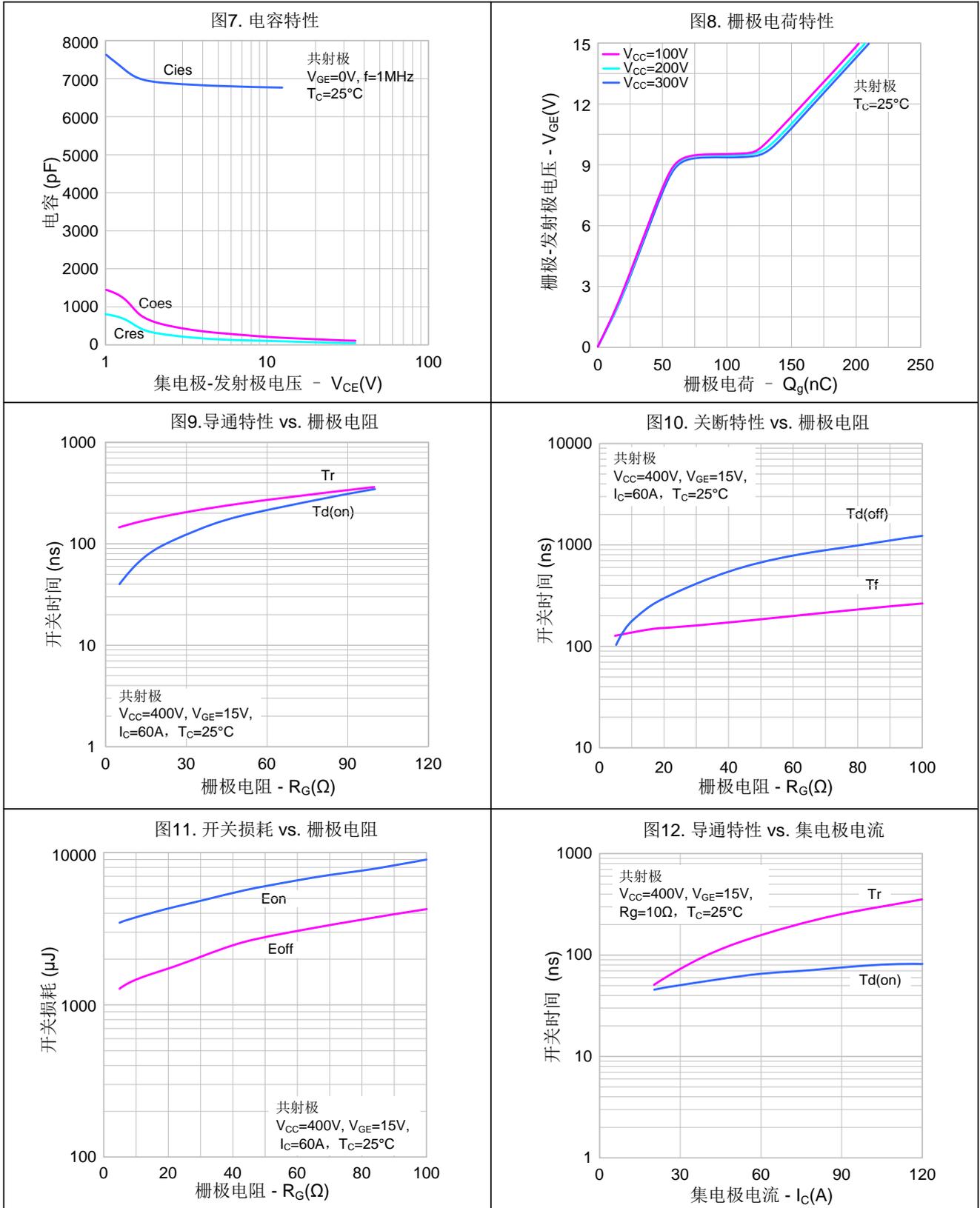
FRD 电性参数（除非特殊说明， $T_C=25^{\circ}\text{C}$ ）

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
二极管正向压降	V_{FM}	$I_F=30\text{A}$, $T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	1.97	--	V
		$I_F=30\text{A}$, $T_C=125^{\circ}\text{C}$	--	1.65	--	
二极管反向恢复时间	T_{rr}	$I_{ES}=30\text{A}$, $dI_{ES}/dt=200\text{A}/\mu\text{s}$	--	36	--	ns
二极管反向恢复电荷	Q_{rr}	$I_{ES}=30\text{A}$, $dI_{ES}/dt=200\text{A}/\mu\text{s}$	--	80	--	nC

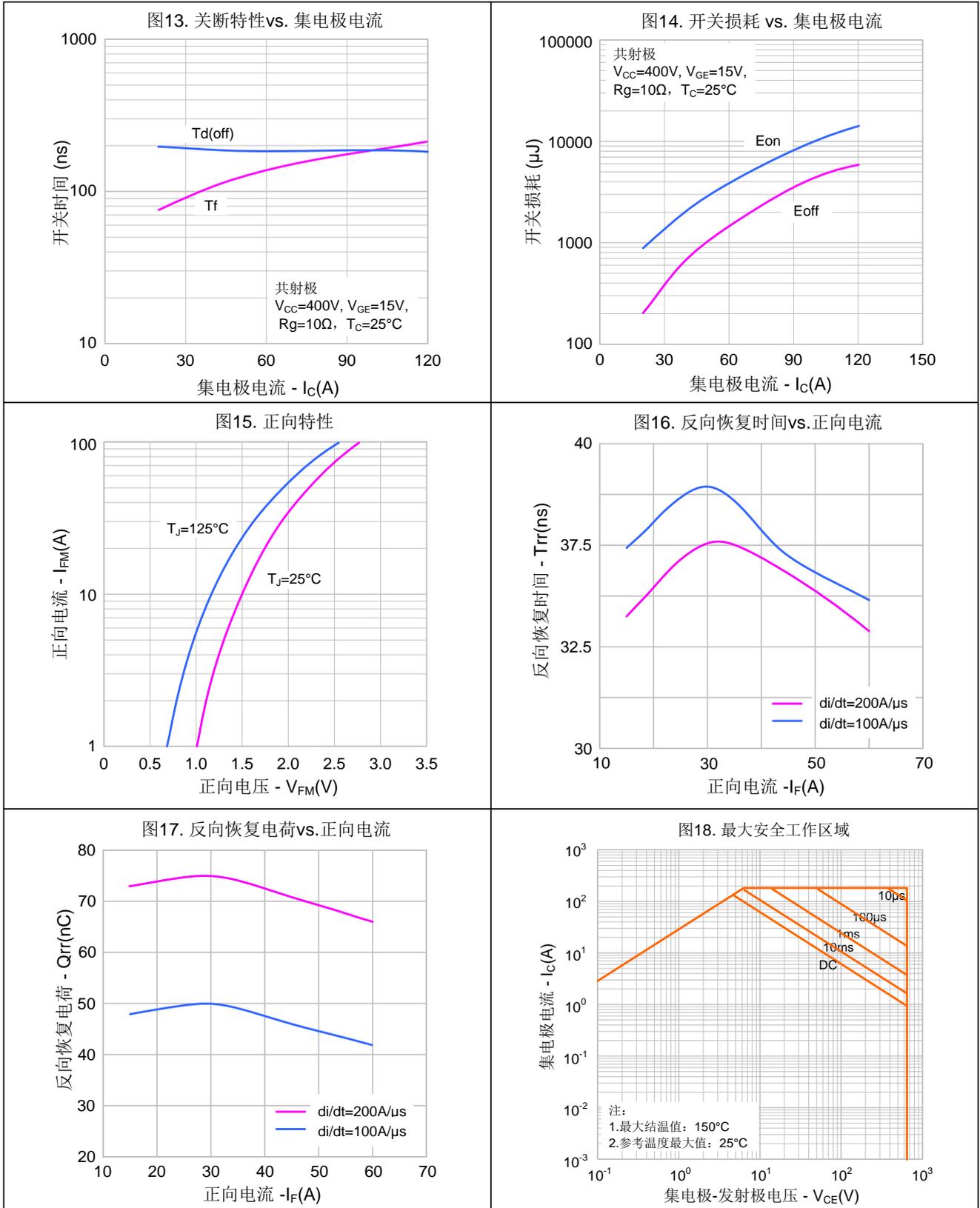
典型特性曲线



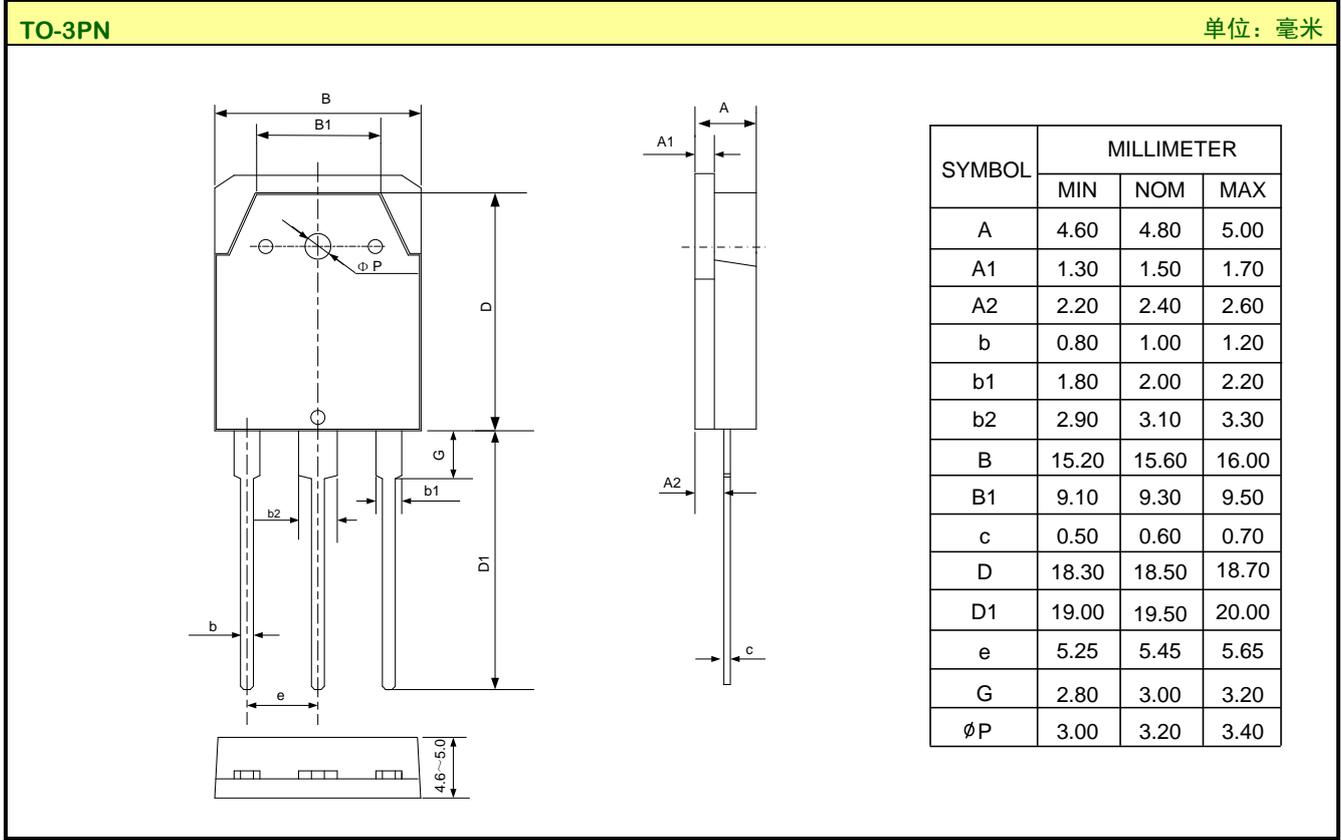
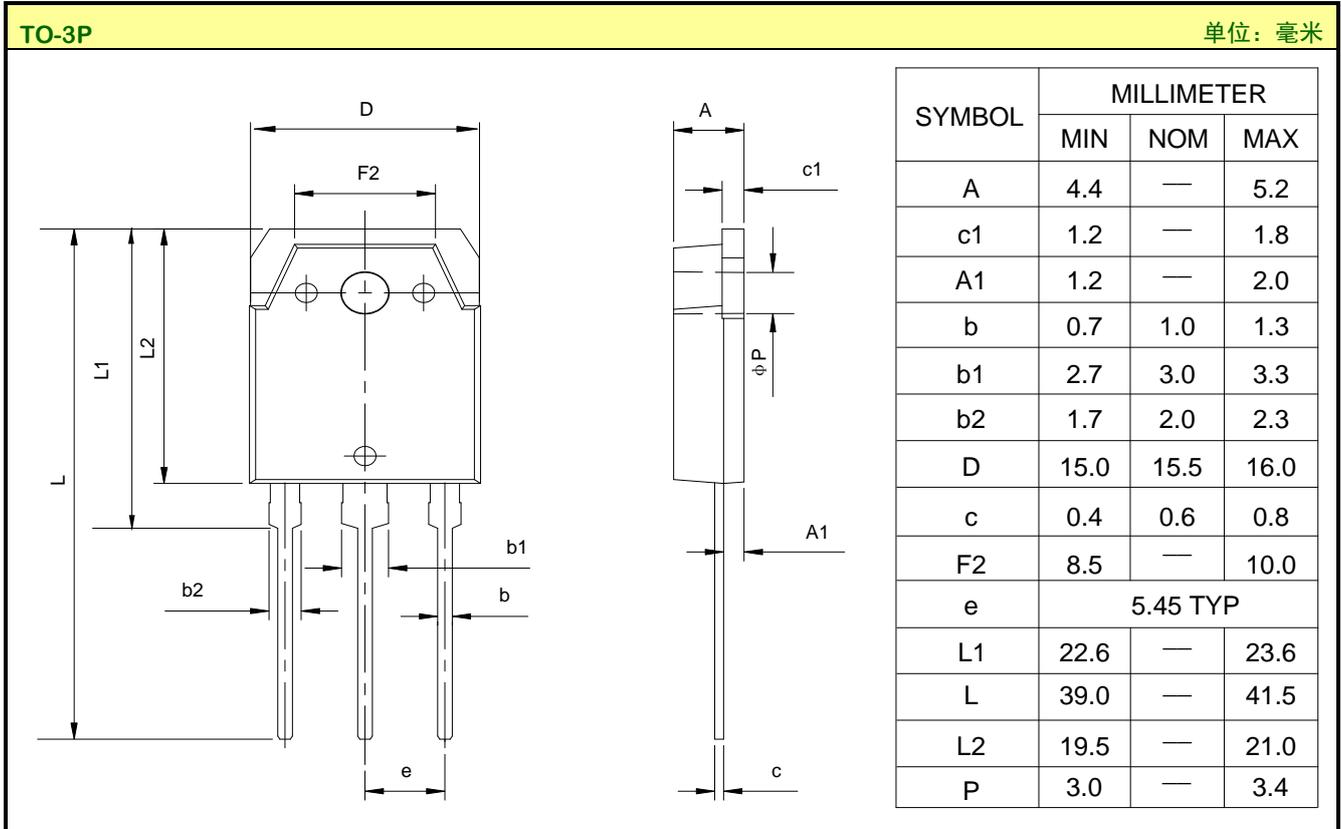
典型特性曲线 (续)



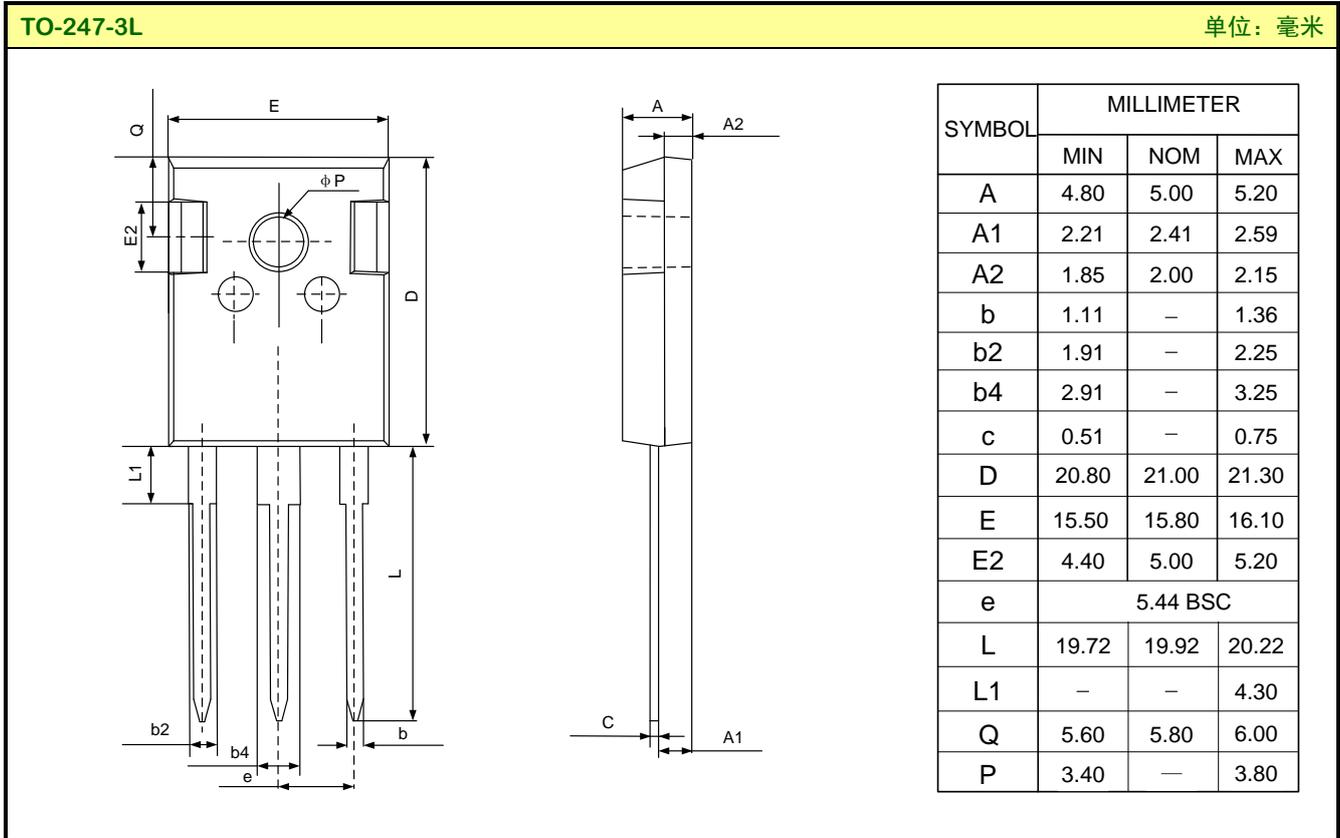
典型特性曲线 (续)



封装外形图



封装外形图 (续)



重要注意事项:

1. 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料, 并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书, 包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值, 否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标, 如有疑问请与本公司联系。
6. 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!
7. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称:	SGT60U65FD1PN(PT)(P7)	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.2

修改记录:

1. 添加 SGT60U65FD1P7(TO-247-3L)封装
2. 修改 I_F , 增加 $T_C=100^\circ\text{C}$ 时的 T_F 电流值

版 本: 1.1

修改记录:

1. 添加 TO-3PN 封装
2. 更新说明书模板 (使用按比例调整的立体图, 标准化后的封装外形图, 更新曲线模板, 更新重要注意事项)

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布
-
-

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>SILAN\(士兰微\)](#)